

平成 18 年 7 月期 決算短信（非連結）

平成 18 年 9 月 15 日

会 社 名 サムコ 株式会社

コード番号 6387

(URL <http://www.samco.co.jp>)

本社所在地 京都府京都市伏見区竹田糞屋町 36 番地

代表者 代表取締役社長 辻理

問合せ先責任者 管理本部長兼経理部長 田井彰

決算取締役会開催日 平成 18 年 9 月 15 日

定時株主総会開催日 平成 18 年 10 月 26 日

配当支払開始予定日 平成 18 年 10 月 27 日

上場取引所 JASDAQ

本社所在都道府県 京都府

T E L (075) 621-7841

中間配当制度の有無 有

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100 株)

1. 18 年 7 月期の業績 (平成 17 年 8 月 1 日～平成 18 年 7 月 31 日)

(1) 経営成績

(注) 金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
18 年 7 月期	3,079 (△ 0.4)	162 (△36.9)	158 (△40.0)
17 年 7 月期	3,090 (△ 8.4)	258 (△40.6)	263 (△35.9)

	当 期 純 利 益	1 株 当 た り 当 期 純 利 益	潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 た り 当 期 純 利 益	自 己 资 本 当 期 純 利 盈 率	総 資 産 經 常 利 益 率	売 上 高 經 常 利 益 率
	百万円 %	円 錢	円 錢	%	%	%
18 年 7 月期	98 (△40.9)	20 05	—	1.9	2.3	5.1
17 年 7 月期	166 (△33.9)	33 96	—	3.3	3.8	8.5

- (注) 1. 持分法投資損益 18 年 7 月期 一百万円 17 年 7 月期 一百万円
 2. 期中平均株式数 18 年 7 月期 4,889,140 株 17 年 7 月期 4,889,140 株
 3. 会計処理の方法の変更 無
 4. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率
 5. 期中平均株式数及び期末発行済株式数は自己株式控除後のものです。

(2) 財政状態

	総 資 産	純 資 産	自己資本比率	1 株 当 た り 純 資 産
	百万円	百万円	%	円 錢
18 年 7 月期	6,976	5,078	72.8	1,038 64
17 年 7 月期	6,830	5,046	73.9	1,032 11

- (注) 1. 期末発行済株式数 18 年 7 月期 4,889,140 株 17 年 7 月期 4,889,140 株
 2. 期末自己株式数 18 年 7 月期 1,750 株 17 年 7 月期 1,750 株

(3) キャッシュ・フローの状況

	営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー	現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高
	百万円	百万円	百万円	百万円
18 年 7 月期	6	83	△ 273	943
17 年 7 月期	168	△ 47	△ 168	1,122

2. 19 年 7 月期の業績予想 (平成 18 年 8 月 1 日～平成 19 年 7 月 31 日)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円
中 間 期	1,900	230	138
通 期	3,800	460	276

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 56 円 45 錢

3. 配当状況

・ 現金配当	1 株当たり配当金 (円)			配当金総額 (百万円)	配当性向 (%)	純資産 配当率(%)
	中間期末	期 末	年 間			
17 年 7 月期	—	12.50	12.50	61	36.8	1.2
18 年 7 月期	—	12.50	12.50	61	62.3	1.2
19 年 7 月期 (予想)	—	15.00	15.00			

※ 上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる場合があります。なお、上記の予想の前提条件その他に関する事項については、添付書類の 6 ページを参照してください。

添付書類

1. 企業集団の状況

当社は、半導体等電子部品製造装置メーカーで、薄膜形成・加工装置の製造及び販売を事業としております。また、単独で事業を営んでおり、親会社や関係会社はありません。

当社の製品は、薄膜を形成するCVD (Chemical Vapor Deposition=化学的気相成長) 装置、薄膜を微細加工するエッチング装置、基板表面などをクリーニングする洗浄装置、その他装置等に区分されます。

(1) 各々の装置分類毎の概要は以下の通りであります。

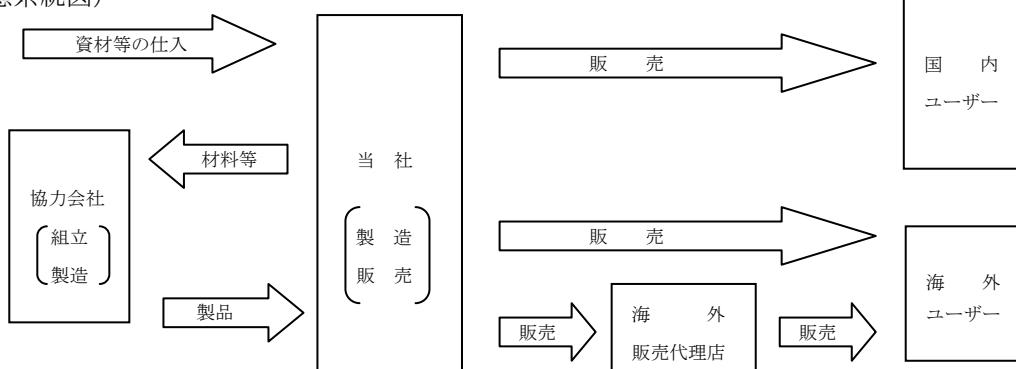
装置区分	概要
CVD装置	反応性の気体を基板の上に堆積させる装置で、一般に半導体、電子部品製造のための半導体膜、絶縁膜、金属薄膜などを形成するために使われます。特に当社は引火性のガスを使用しない液体原料を活用したLS-CVD装置 (LS=Liquid Source) に特徴があり、比較的低温反応で成膜速度が速く、均一性の良い成膜が可能であります。
エッチング装置	各種半導体基板上の半導体薄膜、絶縁膜をはじめ微細加工が必要な材料をドライ加工する装置で、反応性の気体をプラズマ分解し、目的物と反応させて蝕刻していくものです。当社はICP (Inductive Coupled Plasma=高密度プラズマ) を利用したエッチングに特徴があり、高速かつ均一性の優れた加工が可能であります。
洗浄装置	当社の装置は溶液を使用しないドライ洗浄方式で、減圧下で反応性の気体をプラズマ放電させて洗浄するところに特徴があります。高速で自動運転が可能であるため、高集積化を要求されるフィルム状実装基板などに使用されております。
その他装置	上記装置には含まれない特別な装置であります。
その他	部品、保守メンテナンスなどであります。

(2) 当社事業の用途別セグメントは次の通りであります。

用途	概要
オプトエレクトロニクス分野	電気信号を光信号に変換したり、逆に光信号を電気信号に変換したりするデバイスで、主に化合物半導体で作られています。LED (Light Emitting Diode=発光ダイオード) やLD (Laser Diode=半導体レーザー) などの発光デバイス、光導波路などの光通信用デバイスがあります。
電子部品分野	各種センサー・マイクロマシン・磁気ヘッド・SAW (Surface Acoustic Wave=弾性表面波) デバイス・水晶デバイス・高周波デバイス等に関する分野と三次元LSI (Large Scale Integrated circuit) ・三次元パッケージやウェハー欠陥解析などのシリコンデバイス分野です。
実装・表面処理分野	半導体パッケージ技術や表面洗浄技術等の実装・表面処理に関する分野。高密度実装に対応するために、基板はますます小型化、薄型化、多ピン化しています。特にBGA (Ball Grid Array) には、信頼性の高い洗浄機能が要求されています。
表示デバイス分野	有機EL (Electro Luminescence) 、LCD (Liquid Crystal Display=液晶表示素子) 、PDP (Plasma Display Panel) 、などに関する分野。
その他分野	その他分野。
部品・メンテナンス	部品・メンテナンスに関する分野です。

当社の装置の製造に関しては、自社の設計企画により協力会社に製造を委託し、製品出荷の前に独自のプログラムソフトを入力し、仕様検査・出荷検査を経て販売しております。販売に関しては営業所を通じて行うとともに、海外については一部現地販売代理店に委託しており、これらの関係を図示すると以下の通りとなっております。

(業態系統図)



2. 経営方針

(1) 経営の基本方針

当社は「薄膜技術で世界の産業科学に貢献する」ことを経営理念とし、

①創造性を重視し、常に独創的な薄膜製造、加工装置を世界の市場に送る。

②直販制度を採用し、ユーザーニーズに対応した製品をタイムリーに提供する。

③事業が社会に果す役割を積極的に認識し、高い付加価値の追求を目的とし、株主、取引先、役員、従業員に対し、適切な成果の配分をする。

を経営方針に掲げ、事業を展開しております。

(2) 利益配分に関する基本方針

当社は株主の皆様への利益還元を経営の重点政策として位置付けております。経営体質の強化と研究開発のための設備投資等のために必要な内部留保を確保しつつ、安定配当を継続していくことを基本方針としております。

(3) 投資単位の引き下げについて

当社は、当社株式の流動性の向上と株主数の増加を資本政策上の重要な課題と認識しております。

特に 1 単元株式数の見直しによる株式投資単位の引き下げにつきましては、投資家の皆様により投資しやすい環境を整えるために実行すべき課題として認識しております。当社では、既に、平成 16 年 12 月 1 日付をもって 1 単元の株式の数を 1,000 株から 100 株に変更し、株主数は現在増加傾向にあります。更なる引下げにつきましては、今後の動向を見ながら慎重に検討し対処いたしたいと考えております。

(4) 目標とする経営指標

当社は中期的にも収益力の高い企業であり続けようと考えております。そのため売上高総利益率 50% を確保し売上高の拡大により売上高経常利益率 20% 台への向上、維持を目指します。売上高の拡大のためには、研究開発用途向け装置に加えて生産用途向け装置の拡販に努めるとともに、海外売上高比率を現在の 20% 台から早期に 30% 台へ引上げる方針です。

(5) 中長期的な会社の経営戦略

当社は化合物半導体を中心としたオプトエレクトロニクス分野や高周波デバイス分野、電子部品分野に経営資源を集中しながら、中期的には次の 3 点について事業を展開してまいります。

①生産機市場の拡大

既に各種照明、信号機、液晶、バックライトとして需要の拡大している白色および青色 LED や次世代大容量光ディスク用途向けに注目されている青色 LD の量産化への対応及び薄膜ヘッド、 SAW デバイスなどの各種電子部品製造分野等への対応のため、本格的な生産用途向けの装置を開発し、メンテナンスを含めた販売力を強化していくことあります。

②海外市场展開

上記分野も含めて、生産用と研究開発用が同時進行で拡大すると予想されている中国市場を始めとする海外市場への積極展開であります。平成 16 年 11 月に上海事務所を開設し、販売力の強化とアフターサービスの向上を図っており、順調に市場開拓が進んでおります。また、インド市場を始め常に新たな海外市場の発掘に努め中期的には海外売上高比率 30% を目指します。

③新事業の創造と収益化

CVD 装置、エッティング装置、洗浄装置といった当社の三大製品群に次ぐバイオ・IT 分野の“第四の柱”を確立することあります。当社は、米国オプトフィルムズ研究所（シリコンバレー）、英国ケンブリッジ大学との 3 極体制で行っている研究開発と国内の大学や各種クラスターとの共同研究を行っておりますが、これらの中から、薄膜事業に関連する新事業、新分野をいち早く立ち上げ、当社の中期的な事業拡大に寄与する事業に成長させたいと考えております。

(6) 対処すべき課題

中長期戦略に基づき、当社は薄膜技術に対応したオプトエレクトロニクス・電子部品等の分野に今後も積極的に経営資源を投入し、社会に貢献すべく「薄膜技術で世界の産業科学に貢献する」を経営理念に企業革新を一層進めてまいります。主な課題は以下のとおりです。

①生産機市場の販売力強化

近年生産機市場の拡大に向けて生産機用途向け装置の開発、市場開拓、製品サービス体制の充実に取組んでまいりました。また、これまでの研究開発用装置中心の事業活動から、生産機市場による新たな成長に向けての決意を表明し、新しく企業イメージをアピールすべく、平成 16 年 12 月に社名を株式会社サムコインターナショナル研究所からサムコ株式会社に変更しております。更に生産機分野への本格的参入のため新設いたしました「生産機事業部」は、専任部署として開発から設計・営業・製造・納入までの全工程を一元的に統括管理し、新市場の開拓、顧客ニーズへの対応強化による拡販に注力しており、生産用途向け大型装置の受注は当期下半期より大幅に増加し、次期の飛躍に向けた成果が現われつつあります。しかし本格的な生産機市場の拡大には更なる販売力強化の必要性を認識しております。重点顧客のニーズを的確に把握する組織的機動的な営業力強化とともに、専門性の高い人員確保の強化により顧客満足度の向上を通じてサムコブランドの確立を目指してまいります。

②海外市場拡販への布石

中長期戦略の海外売上高比率 30% を達成するにはアジア地域、特に台湾・中国と北米を重点市場とした拡販が不可欠と認識しております。このため、海外マーケットの開拓と営業力の強化は重要な課題であり、各方面に広く門戸を開設し、中途採用を強化するとともに、独自の社内研修システムを充実していく方針であります。更に海外の専門家ともアドバイザリー契約を締結、中国の有力大学との共同研究の準備も進めており、更なるグローバル展開に向けた事業展開を加速してゆく所存であります。

③次世代技術の開発と事業化

デジタル家電関連の大手各社が設備投資を活発化させる中、当社の技術的優位性を活かした化合物半導体が用いられる LED や LD のオプトエレクトロニクス市場、三次元 LSI などで高性能化を進める電子部品市場が引き続き当社の中心市場となります。IT バブル崩壊後の通信分野の需要回復時期や新エネルギー分野への参入による事業の拡大が必要であると考えております。

現在開発中でありますオプトエレクトロニクス分野の LED 、 LD 生産用途向けの次世代 MOCVD (Metal Organic Chemical Vapor Deposition) 装置の商品化や事業拡大のための業務提携についても積極的に情報を入手し事業基盤の更なる強化を行ってまいります。

以上のように、当社は生産機市場における拡販とグローバル展開、新規事業の創造によって強靭な企業成長を加速させてまいります。

(7) 親会社等に関する事項

当社は親会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

(8) 内部管理体制の整備・運用状況

本事項の詳細につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所が平成 18 年 6 月 1 日に開示いたしました「コーポレートガバナンス報告書」に記載しておりますので、ご参照ください。

(9) その他、会社の経営上の重要な事項

該当事項はありません。

3. 経営成績及び財政状態

(1) 経営成績

当期のわが国経済は、上半期は企業収益の回復に支えられた設備投資意欲の強さと個人消費の堅調さを背景に景気は回復基調に入り、外国人投資家の日本株投資により株式市場も急回復し、下半期には株式市場が調整局面をむかえる中でデフレ脱却論が論議され 7 月には日銀のゼロ金利政策が解除される状況下で推移いたしました。

当社を取り巻く半導体等電子部品業界におきましても、デジタル家電関連企業の在庫調整が一巡し設備投資も活発化いたしました。

こうした環境の中、これまで研究開発に注力してまいりました半導体の高集積化に大きく期待される三次元 L S I 向けに絶縁膜形成用 C V D 装置の受注が好調となりました。また、下半期には当社の販売の中心分野である L E D や L D などの照明用途と光源用途を柱とするオプトエレクトロニクス分野向けにエッティング装置と C V D 装置の販売が、台湾向け輸出を中心に拡大いたしました。海外売上高は 635 百万円(前期比 15.6% 増)と増加し、海外売上高比率は前期の 17.8% から 20.6% へと上昇いたしました。電子部品分野向けの販売は、携帯電話用途で一部回復いたしましたが各種センサー用途やマイクロマシン用途で減少いたしました。製品開発では、微細化・高精度化が進展するマイクロマシン分野や電子部品分野向けに、独ロバート・ボッシュ社よりの技術(ボッシュプロセス)導入で開発しましたシリコンディープエッティング(深掘)装置の高速性能化を図り新製品 R I E - 800 i P B を発表いたしましたが、開発の遅れにより本格的な販売展開は来期以降となりました。また、前期に引き続き三次元 L S I 用の専用機の開発、L E D や L D 用途向け次世代 M O C V D 装置の開発など成長分野に的を絞った積極的な研究開発活動を推進いたしました。また、当社と英国ケンブリッジ大学で共同開発した強誘電体ナノチューブの製造技術を米英企業にライセンス供与、将来的には特許権使用料収入も期待されます。顧客サービス充実のため製品サービスセンターを新設し、生産機用途向け装置を中心に 24 時間のサービス体制を整えました。重要商談については、個々のプロセス開発にも積極的に取組みました。既存装置については、仕様の見直し、設計の標準化による製造原価のコスト削減に注力いたしました。

以上のような活動をしてまいりましたが、装置の大型化に伴い商談から出荷までの期間が長期化し売上計上が一部来期にずれ込んだことから、当期の売上高は 3,079,435 千円(前期比 0.4% 減)となりました。経常利益は新型装置の試作開発費の増加等もあり 158,356 千円(前期比 40.0% 減)となり、純利益は 98,049 千円(前期比 40.9% 減)となりました。

(C V D 装置)

三次元 L S I 用や各種センサー用の絶縁膜形成用途で大型 C V D 装置の受注が獲得できましたが、表示デバイス分野、オプトエレクトロニクス分野での落込みを補えず、売上高は 692,491 千円(前期比 19.3% 減)と減少いたしました。

(エッティング装置)

生産用途向けに需要が拡大、海外向けではオプトエレクトロニクス分野で L E D 用途向けの販売が伸び、半導体回路の欠陥解析用で引き続き受注が獲得できました。電子部品向けの需要が一時的に減少いたしましたが、H B T (Heterojunction Bipolar Transistor=ヘテロ接合バイポーラ・トランジスタ)など高周波デバイスや携帯電話用 S A W フィルター用途の受注が増加し期末受注残の確保につながりました。その結果、売上高は 1,581,782 千円(前期比 7.1% 増)へと増加いたしました。

(洗浄装置)

プラスチック半導体パッケージの表面洗浄やワイヤーボンディング前の電極洗浄分野や表示デバイスの表面処理用途等で幅広い需要がありました。売上高は 393,130 千円(前期比 6.2% 増)となりました。

(その他装置)

その他装置の売上高は 4,950 千円となりました。

(その他)

既存装置のメンテナンスや改造及び部品販売が比較的安定的に推移し、売上高は 407,080 千円(前

期比 5.6%増)となりました。

(品目別売上高)

品 目	売上高(千円)	構成比(%)	前期比(%)
C V D 装 置	692,491	22.5	△19.3
エッチング装置	1,581,782	51.4	7.1
洗 淨 装 置	393,130	12.8	6.2
そ の 他 装 置	4,950	0.1	—
そ の 他	407,080	13.2	5.6
合 計	3,079,435	100.0	△0.4

(用途別売上高)

用 途	売上高(千円)	構成比(%)	前期比(%)
オプトエレクトロニクス分野	1,098,987	35.7	29.3
電 子 部 品 分 野	1,075,777	34.9	△13.4
実装・表面処理分野	110,440	3.6	△42.1
表示デバイス分野	127,443	4.2	△37.9
そ の 他 分 野	259,705	8.4	19.6
部品・メンテナンス	407,080	13.2	5.6
合 計	3,079,435	100.0	△0.4

(2) 次期の見通し

次期の見通しにつきましては、当期末の受注残高が 1,200 百万円台と近年にない高いレベルとなり、生産機用途向けエッチング、CVD 装置“C シリーズ”で大型案件がいよいよ業績に寄与し始めたことや、中国・アジア市場での拡販による売上高の急速な拡大が見込まれます。また、電子部品分野では携帯電話、各種センサー、マイクロマシンなどの小型化、高機能化のニーズに応える装置の受注が見込めます。高速性能が更に向上了したボッシュプロセス搭載のエッチング装置 RIE-800iPB は、MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) 市場での販売に期待がもてます。更に海外を含め LED や LD 用途での高密度プラズマエッチング装置の販売や通信分野での需要の回復も期待されます。研究開発用途向け装置は大学・研究機関への販売回復に加え、基礎研究分野への積極投資にかかる需要もあり、順調な増加を予想しています。洗浄装置につきましては、新型機種を投入し北米・東南アジアを中心に販売を強化いたします。売上総利益率は生産機市場における競争激化が予想されるものの、部品仕入れから一貫した原価低減と装置・部品の標準化の推進等により 50%以上の一層の向上を図ります。一方、販売費及び一般管理費は研究開発費および中途採用人材に関する人件費の増加は見込まれますが、コスト削減活動の強化により固定費の増加要因は限定的と見られ、対売上高比率はより低下できるものと予想されます。

以上の見通しにより、売上高は 3,800 百万円(前期比 23.4% 増)、経常利益は 460 百万円(前期比 190.5% 増)、当期純利益は 276 百万円(前期比 181.5% 増)となる見込みであります。

(3) 財政状態

(流動資産)

当期末における流動資産は、3,754 百万円で前期末に比べ 171 百万円増加いたしました。現金及び預金が 276 百万円減少した一方、売掛債権は受取手形が 52 百万円、売掛金が 188 百万円、たな卸資産は 193 百万円それぞれ増加いたしました。

(固定資産)

当期末における固定資産の残高は、3,221 百万円で前期末に比べ 25 百万円減少しました。主な減少要因は、建物の減価償却で 35 百万円、投資有価証券で 7 百万円であります。

(流動負債)

当期末における流動負債の残高は、1,497 百万円で前期末に比べ 145 百万円増加しました。買掛金が 261 百万円の大幅増となった一方、一年以内返済予定長期借入金が 106 百万円減少、短期借入金の純減少額も 49 百万円となりました。

(固定負債)

当期末における固定負債の残高は、401百万円で前期末に比べ30百万円減少しました。長期借入金の純減少額56百万円が主な要因であります。

(純資産)

当期末における純資産の残高は、5,078百万円で前期末に比べ31百万円増加しました。これは、利益剰余金が36百万円増加したことなどによります。自己資本比率は総資産が146百万円増加したため前期比1.1ポイント低下し、72.8%となりました。

(4) キャッシュ・フローの状況

当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は税引前当期純利益が158,356千円（前期比40.0%減）となり、仕入債務の増加額261,643千円がプラスに寄与したものの、売掛債権の増加241,573千円、たな卸資産の増加195,767千円、借入金の返済212,138千円（うち短期借入金純減少額49,498千円、長期借入金純減少額162,640千円）などにより、資金残高は前期末に比べ178,657千円減少し、当期末には943,640千円（前期比15.9%減）となりました。

また、当期における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は6,875千円（前期比95.9%減）となりました。これは主に仕入債務の増加額261,643千円、退職給付引当金の増加額12,758千円がプラスに寄与したものの、税引前当期純利益が158,356千円となり、売掛債権の増加241,573千円、たな卸資産の増加が195,767千円であったことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果得られた資金は83,063千円（前期に使用した資金47,568千円）となりました。その主な内容は定期預金の預入による支出1,752,002千円に対して、定期預金の払出による収入が1,850,222千円であったことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は273,253千円（前期比62.0%増）となりました。これは、借入金の返済による支出212,138千円、配当金の支払61,114千円によるものです。

なお、直近5事業年度におけるキャッシュ・フロー指標の推移は次のとおりであります。

	平成14年 7月	平成15年 7月	平成16年 7月	平成17年 7月	平成18年 7月
自己資本比率（%）	65.1	66.1	71.2	73.9	72.8
時価ベースの自己資本比率（%）	142.1	130.0	167.7	134.9	91.1
債務償還年数（年）	4.1	15.2	2.5	5.4	101.4
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	14.0	3.8	21.7	11.7	0.6

- (注) • 自己資本比率：自己資本／総資産
• 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産
• 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー
• インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／支払利息